




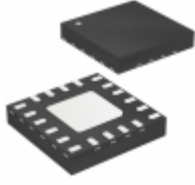

	<p><b>SI3499DV-T1-E3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI3499DV-T1-E3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 8V 5.3A 6-TSOP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI3499DV-T1-E3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 21825 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI3499DV-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 8V 5.3A 6-TSOP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	21825 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 8V 5.3A (Ta) 1.1W (Ta) Surface Mount 6-
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	1.1W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	8V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.3A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	23 mOhm @ 7A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	750mV @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	42nC @ 4.5V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±5V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI3499DV-T1-E3TR



























SI3499DV-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI3499DV-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3499DV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3499DV-T1-E3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI3499DV-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 8V 5.3A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3495DV-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 5.3A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3499DV-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 8V 5.3A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3495DV-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 5.3A 6-TSOP</p>
 <p><b>SI3500-A-GM</b> Energy Micro (Silicon Labs) IC REG BUCK ADJ 0.4A 20QFN</p>	 <p><b>SI3500-A-GMR</b> Energy Micro (Silicon Labs) IC REG BUCK ADJ 0.4A 20QFN</p>	 <p><b>SI3495DV-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 5.3A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3495DV</b> VISHAY SI3495DV VISHAY</p>

heiße Teile

Mehr

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited